

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上字第3號

上訴人 致茂電子股份有限公司

法定代理人 黃欽明

訴訟代理人 張哲倫律師

陳佳菁律師

複代理人 蔡昀廷律師

訴訟代理人 金若芸

被上訴人 惠特科技股份有限公司

兼上一人

法定代理人 徐秋田

上二人共同

訴訟代理人 黃世瑋律師

輔佐人 詹偉鴻

訴訟代理人 廖鈺達

劉沁瑋

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年1月6日本院111年度民專訴字第44號第一審判決提起上訴，本院於112年11月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬本院，依修正施行後第75條第1項之規定，除經兩造合意適用修正施行後第53條規定（二審卷二第170頁）之外，自應適用修正施行前之規定，先予敘明。

01 二、上訴人主張：伊為中華民國第I431291號「發光二極體量測
02 裝置」發明專利(下稱系爭專利)之專利權人，專利權期間自
03 103年3月21日至120年7月13日止。伊與被上訴人惠特科技股
04 份有限公司(下稱惠特公司)均從事機械設備、光學儀器製造
05 及銷售等業務，惠特公司所製造、販賣、為販賣要約或使用
06 之「LFP 7004覆晶型LED晶粒/晶圓點測機」(下稱系爭產
07 品)，經搭配使用系爭產品不可或缺，可由市場輕易取得之
08 擴張環(含其上透明薄膜)組裝後進行測試分析，結果顯示系
09 爭產品已落入系爭專利請求項1至4、7之技術特徵範圍而構
10 成文義侵害，縱使兩造對於請求項1其中「透明基板(即1B
11 要件)」、「間隔構件(即1C要件)」之解釋不同，亦構成均
12 等侵權。又系爭產品雖然欠缺擴張環之元件，如認惠特公司
13 並非直接侵權行為人，然其明知並有預見或可避免侵害系爭
14 專利致生損害之能力，仍未注意而使系爭產品流通於市場
15 上，致系爭產品之使用者搭配結合原缺乏之擴張環使用而直
16 接侵害系爭專利請求項1至4及7，乃為造意、幫助侵害系爭
17 專利之共同侵權行為人，並因此獲有不法之利益，自應負排
18 除侵害及損害賠償或返還不法利益之責任。再者，被上訴人
19 徐秋田(下稱徐秋田，並與惠特公司合稱被上訴人)自97年8
20 月8日起擔任惠特公司之法定代理人兼總經理，參與系爭產
21 品之製造、販賣、為販賣之要約或使用，應於其擔任惠特公
22 司法定代理人之期間，與惠特公司負排除侵害及連帶給付之
23 責任。爰依專利法第96條第1項規定請求排除被上訴人侵
24 害，及依同法第96條第2項、第97條第1項第2款、第2項、民
25 法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段、第185條及
26 公司法第23條規定，並以被上訴人因侵害行為之所得利益為
27 據，請求被上訴人連帶給付新臺幣(下同)1,000萬元本息等
28 情。

29 三、被上訴人抗辯：

30 (一)系爭產品並未落入系爭專利請求項1至4、7之文義或均等範
31 圍，亦未構成共同侵權行為：

01 系爭產品並不具備系爭專利請求項1所載「間隔構件」、
02 「軟性透明載體」零件，上訴人所稱之擴張環並非系爭產品
03 之一部分，且擴張環之外框係設置於吸盤外圍之金屬部分，
04 與請求項1所界定之間隔構要件係設於透明基板元件不同，
05 縱使系爭產品可以搭配擴張環使用，因擴張環之外框並無間
06 隔概念且具有剛性，吸盤外圍之金屬部分亦具備一定之剛
07 性，兩者之間無法提供密閉功能，亦無由「透明基板」、
08 「間隔構件」、「軟性透明載體」所共同形成之密閉空間，
09 並未落入系爭專利請求項1之文義或均等範圍。又系爭專利
10 請求項2至4、7為請求項1之直接或間接附屬項，均具有請求
11 項1之技術特徵，故系爭產品亦未落入系爭專利請求項2至
12 4、7之範圍，並未對系爭專利請求項1至4、7構成文義或均
13 等侵害。再者，系爭產品之用途為測試機台，可因製程之不
14 同搭配disco frame使用，並非僅能搭配上訴人所稱擴張還
15 使用，即使無擴張環亦可運作，並無上訴人所指專為侵權用
16 途，且上訴人並未舉證何人為直接侵權行為人，被上訴人無
17 從造意或幫助，亦否認在製造販售系爭產品上有造意或幫助
18 他人侵害系爭專利之故意或過失存在。

19 (二)縱系爭產品落入系爭專利請求項1至4、7之專利範圍，因系
20 爭專利不具進步性，且被上訴人亦可主張先使用權，自為系
21 爭專利效力所不及：

22 依附表所示證據及系爭專利說明書「先前技術」之記載與其
23 證據組合，已足以證明系爭專利請求項1至4、7不具進步
24 性，具有得撤銷之事由，上訴人不得據以向被上訴人主張權
25 利。又假設系爭產品落入系爭專利請求項1至4、7之文義或
26 均等範圍，該等請求項且具進步性，惟依系爭專利申請日
27 前，即100年6月7日惠特公司員工間寄送之電子郵件所夾帶
28 之檔案，所揭示LEP6000覆晶檢測器，可配合白膜/藍膜使
29 用，以產生真空吸附白膜/藍膜達到固定待測晶片之功效，
30 已就製造此類機台及銷售完成必要之準備，依專利法第59條
31 第1項第3款前段規定，自為系爭專利之專利權效力所不及。

另因系爭產品未對系爭專利構成侵權，被上訴人製造販賣系爭產品無需上訴人之同意或授權，非無法律上原因而受有利益，亦不符不法無因管理之要件等語。

四、原審判決駁回上訴人之訴及假執行聲請，上訴人提起上訴並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(三)被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品及其他侵害系爭專利之產品。(四)就第2項及第3項之聲明，上訴人願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

五、兩造不爭執事項(二審卷一第290頁)：

- (一)上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自103年3月21日起至120年7月13日止。
- (二)惠特公司主要業務如原證(甲證)4經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務畫面所示。
- (三)系爭產品為被上訴人製造、為販賣之要約、販賣及使用之產品。
- (四)原證(甲證)5為惠特公司銷售系爭產品之規格簡介說明資料，原證(甲證)7影片中所示為系爭產品，原證(甲證)8為惠特公司109年年報之摘要內容。
- (五)系爭產品工作檯檢測區下方基板為透明。

六、本院判斷：

- (一)系爭產品本身因欠缺擴張環元件，並未落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍，不構成文義侵權：

1.系爭專利請求項1至4、7之技術特徵(主要圖式如附圖所示)：

(1)請求項1共有6個技術特徵(解析為1A至1F)：

1A：「一種發光二極體量測裝置，用於量測一覆晶式發光二極體，該發光二極體量測裝置包含」；

01 1B：「一透明基板，具有一第一面」；

02 1C：「一間隔構件，設置於該第一面上」；

03 1D：「一軟性透明載體，可拆卸地接合於該間隔構件上，
04 其中當該軟性透明載體接合於間隔構件上時，該軟性透明
05 載體、該間隔構件及該透明基板之該第一面之間形成一密
06 閉空間」；

07 1E：「一真空產生器，連接至該密閉空間並用以對該密閉
08 空間抽氣」；

09 1F：「其中，當該透明載體接合於該間隔構件上且該真空
10 產生器對該密閉空間抽氣時，該軟性透明載體部分平貼於
11 該第一面上以形成一檢測區，該檢測區係用以承載該覆晶
12 式發光二極體」。

13 (2)請求項2：如申請專利範圍第1項所述之發光二極體量測裝
14 置，進一步包含一光檢測器，該光檢測器係用以接收自該
15 透明基板而來之光線。

16 (3)請求項3：如申請專利範圍第2項所述之發光二極體量測裝
17 置，進一步包含一探針組，用以接觸承載於該檢測區上之
18 該覆晶式發光二極體的一P-N電極，以及對該P-N電極供給
19 一檢測電源。

20 (4)請求項4：如申請專利範圍第3項所述之發光二極體量測裝
21 置，其中當該探針組接觸接觸承載於該檢測區上之該覆晶
22 式發光二極體的該P-N電極並供給該檢測電源時，該覆晶
23 式發光二極體對應該檢測電源而發光穿過該軟性透明載體
24 之該檢測區以及該透明基板。

25 (5)請求項7：如申請專利範圍第1項所述之發光二極體量測裝
26 置，其中該真空產生器進一步包含一管路，並且該管路係
27 穿過該透明基板而與該密閉空間連接，該真空產生器係透
28 過該管路對該密閉空間抽氣。

29 2.關於請求項1之「透明基板」、「間隔構件」及「密閉空
30 間」之解釋：

01 (1)「透明基板」：依其字面意義，「透明」指「光線可以穿
02 過」或「可透光」；「基板」指「扁平狀的物體或底
03 板」，「透明基板」應解釋為「可透光之板狀元件」。至
04 上訴人主張除可透光之外，尚應解釋為「同時可供放置間
05 隔構件」之元件(二審卷一第288至289頁)，惟此由系爭專
06 利請求項1所界定「一間隔構件，設置於該第一面(即透
07 明基板)上」等內容，即知「透明基板」係可供間隔構件
08 放置，自無庸另為解釋。

09 (2)「間隔構件」：

10 ①依其字面意義，間隔指「事物在空間上的距離」，而請
11 求項1有關軟性透明載體或密閉空間係界定「…當該軟
12 性透明載體接合於間隔構件上時，該軟性透明載體、該
13 間隔構件及該透明基板之該第一面之間形成一密閉空
14 間…」，可知前述「間隔」係指軟性透明載體與透明基
15 板間分隔一距離而言；參酌系爭專利說明書第7頁末段
16 至第8頁第1段記載「…間隔構件32係設置於透明基板30
17 的第一面300之上，並將第一面300圍出一區域。…。透
18 明載體34緊密接觸間隔構件32可密封間隔構件32於第一
19 面300上所圍出之區域，使得軟性透明載體34、間隔構
20 件32以及第一面300之間形成密閉空間S1」，可知間隔
21 構件除了(垂直方向)間隔軟性透明載體與透明基板，另
22 尚需將透明基板圍出一區域(水平方向)，以使軟性透明
23 載體、間隔構件及透明基板三者共同建構出密閉空間，
24 故「間隔構件」應解釋為「用於將透明基板圍出一個區
25 域，使軟性透明載體與透明基板相隔一個距離的構
26 件」。

27 ②至上訴人雖主張由系爭專利之申復理由書(甲證55，二
28 審卷一第185至187頁)，系爭專利之間隔構件可以解釋
29 成用於固定膠膜之套環，例如在生產過程中用於裝載並
30 移動半導體元件的擴張環之外框云云(二審卷一第116至
31 117頁)。惟該甲證55係上訴人在專利申請過程中，針對

01 審查委員質疑系爭專利請求項1之「軟性透明載體」違
02 反專利法第26條第1項規定，申復說明晶片廠在出貨時
03 會將晶片置於膠膜上，而擴晶時會將膠膜予以拉伸後再
04 利用套環固定等實際作法，核其內容係在說明前述膠膜
05 即為請求項1之「軟性透明載體」(同上卷第186頁倒數
06 第2段)，並非在解釋「間隔構件」為何，尚無法作為解
07 釋之依據。

08 ③另上訴人雖依系爭專利說明書第7頁末段及第8頁第1段
09 內容，主張間隔構件係間隔密閉空間與外部環境，且系
10 爭專利說明書第10頁雖提及哪些因素決定「間隔構件之
11 高度」，但未要求間隔構件須能隔開軟性透明載體與透
12 明基板，如解釋為「使軟性透明載體與透明基板相隔一
13 個距離的構件」，將有以圖式限制申請專利範圍之違
14 誤，故應解釋為「將透明基板圍出一個區域，以間隔密
15 閉空間與外部環境之構件」云云(二審卷一第315至319
16 頁)。然依系爭專利請求項1所載，密閉空間係由軟性透
17 明載體、間隔構件及透明基板三者共同形成，亦即將密
18 閉空間與外界環境予以相隔者，並非僅有間隔構件；且
19 間隔構件既係位於透明基板與軟性透明載體之間，復依
20 系爭專利說明書第10頁提及「間隔構件之高度」等內
21 容，足見「間隔構件」並不可能毫無高度(否則即無法
22 構成密閉空間)，則透明基板與軟性透明載體之間自當
23 因間隔構件之故而「相隔一個距離」，況且本院前揭解
24 釋並未限制特定之距離(即特定之間隔構件高度)，並無
25 上訴人所稱將圖式內容不當讀入請求項解釋之情事。

26 (3)「密閉空間」：

27 ①觀諸系爭專利請求項1之「密閉空間」用語，依其上下
28 文所載「…該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板
29 之該第一面之間形成一密閉空間…」、「一真空產生
30 器，連接至該密閉空間並用以對該密閉空間抽氣」，可
31 知「密閉空間」係由軟性透明載體、間隔構件及透明基

01 板(第一面)三者所共同界定，且該空間係與真空產生器
02 相互連通；再參酌系爭專利說明書【實施方式】載明
03 「…軟性透明載體34可拆卸地接合於間隔構件32之上，
04 當透明載體34接合至間隔構件32上時，可於兩者接合處
05 施力使得兩者緊密接觸至無氣漏的程度…透明載體34緊
06 密接觸間隔構件32可密封間隔構件32於第一面300上所
07 圍出之區域，使得軟性透明載體34、間隔構件32以及第
08 一面300之間形成密閉空間S1」、「…由於軟性透明載
09 體34與間隔構件32緊密接觸，使密閉空間S1呈無氣漏狀
10 態，故對密閉空間S1抽氣可於其中產生負壓…」等語，
11 一再強調軟性透明載體與間隔構件間係緊密接觸而使密
12 閉空間無氣漏。另參考外部證據之辭典解釋(乙證15，
13 二審卷一第313頁)，「密閉」係嚴密固封之意。由此足
14 見系爭專利請求項1之「密閉空間」，應係指由軟性透
15 明載體、間隔構件及透明基板三間所共同界定之空間，
16 除了連通於真空產生器以外，均無連通於外部而為氣
17 密，以利於進行抽氣產生負壓。是以，系爭專利請求項
18 1之「密閉空間」，自應解釋為「由軟性透明載體、間
19 隔構件及透明基板三者所共同界定之氣密空間」。

- 20 ②上訴人雖主張請求項1並未限制「密閉空間」之透氣程
21 度，且系爭專利說明書提及「無氣漏之密閉空間」僅係
22 一具體實施例，不能用來限定請求項之密閉空間為百分
23 之百不透氣，故密閉空間應解釋為「由軟性透明載體、
24 間隔構件及透明基板所共同界定的封密空間，且當抽真
25 空時，該封閉空間的氣密程度足以使軟性透明載體部分
26 平貼在透明基板上」(二審卷一第319至321頁)。然
27 而，本院之解釋並未限制氣密程度；再者，系爭專利請
28 求項1與說明書並無任何關於氣密程度，甚或抽真空時
29 氣密程度足使軟性透明載體部分平貼於透明基板上之內
30 容，況且氣密程度實與各構件間之接合方式及構件本身
31 材質之透氣性等因素相關，當不能如上訴人主張將氣密

程度逕自納入專利要件之解釋，故上訴人之主張即非可採。

3.系爭產品本身欠缺擴張環元件，並未落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍：

(1)系爭產品技術分析：系爭產品係被上訴人所生產、銷售用於測試覆晶型發光二極體晶粒之設備，其外觀如原證6第5頁所示（如附圖）。又依系爭產品規格書，系爭產品之基本架構圖如附圖之原證5第4頁所示，主要包含一高透光石英盤及其上方之探針、針座、電流源，以及位於該高透光石英盤下方之積分球（註：用於量測光通量）及檢測發光二極體（即如附圖原證5第7頁圖中之「管芯」）發光特性之相關設備。

(2)1A技術特徵：

系爭產品係用於量測覆晶式發光二極體之光電特性（參系爭產品規格書第4、9頁，原審卷一第67、72頁），故具有系爭專利請求項1之1A技術特徵「一種發光二極體量測裝置，用於量測一覆晶式發光二極體，該發光二極體量測裝置包含」，且為被上訴人所不爭執。

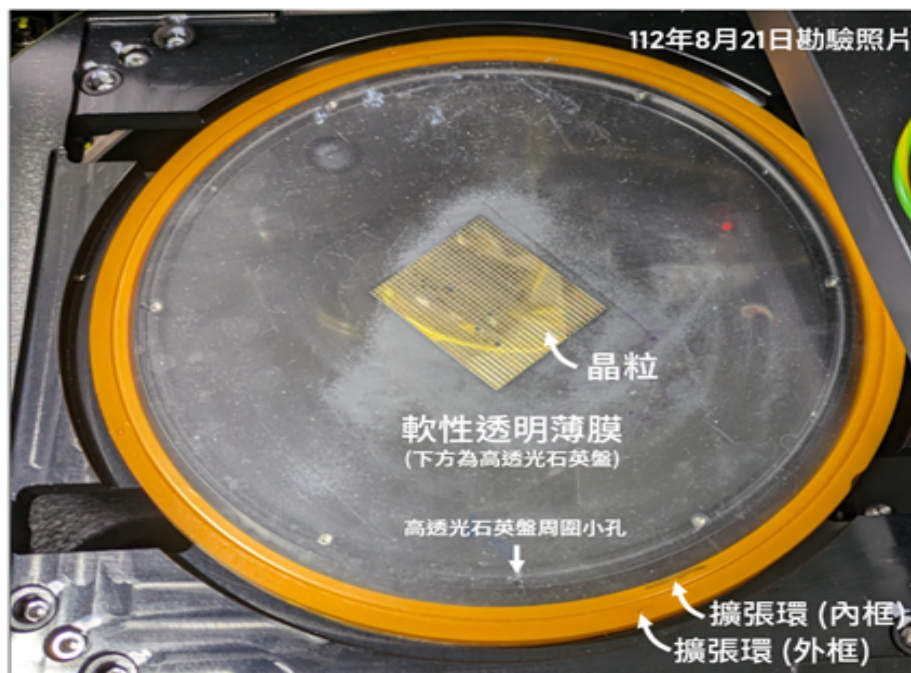
(3)1B技術特徵：



01 依系爭產品規格書所載之測試機基本架構圖(如附圖原證5
02 第4頁)，顯示系爭產品具有高透光石英盤(如系爭產品規
03 格書第7頁所示，位於積分球上方之基板)，即系爭產品照
04 片所示之吸盤(原證6第7頁，原審卷一第81頁上方圖；或
05 見上圖即本院112年8月21日勘驗照片5)中間透光部分，且
06 該高透光石英盤具有可放置發光二極體晶粒之一面，故系
07 爭產品具有系爭專利請求項1之1B技術特徵「一透明基
08 板，具有一第一面」。

09 (4)1C、1D技術特徵：

10 上訴人主張當「擴張環」置於系爭產品吸盤上表面時，該
11 擴張環之橘色外框即對應於系爭專利請求項1之1C技術特
12 徵「一間隔構件，設置於該第一面上」；該擴張環上「軟
13 性透明薄膜」可拆卸地接合於擴張環之橘色外框上，而當
14 擴張環置於吸盤上時，軟性透明薄膜、橘色外框及吸盤
15 (含高透光石英盤)之上表面間形成一密閉空間，即可對
16 應於1D技術特徵「一軟性透明載體，可拆卸地接合於該間
17 隔構件上，其中當該軟性透明載體接合於間隔構件上時，
18 該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板之該第一面之
19 間形成一密閉空間」云云。



惟查，依系爭產品規格書內容（原審卷一第64至72頁）可知，系爭產品本身並無「擴張環」構件，亦即擴張環本身並未附隨系爭產品而出售，並非系爭產品之附屬構件，此為上訴人所不爭執，自無從以系爭產品所無之擴張環外框、軟性透明薄膜分別對應1C、1D之「間隔構件」、「軟性透明載體」，更遑論對應於間隔構件、軟性透明基板與透明基板三者間所形成之「密封空間」，因此系爭產品本身不具有系爭專利請求項1之1C、1D技術特徵。

(5)1E技術特徵：



原證6第9頁



原證6第10頁



原證6第10頁

依系爭產品照片（原審卷一第83、84頁），系爭產品外殼上設有開啟真空功能之「CHUCK TABLE VACUUM」按鈕（本院勘驗照片圖10，二審卷一第464頁），且吸盤下方設有真空管路連接至吸盤側邊，固可推知系爭產品內部設有可進行抽氣之真空產生器。惟因系爭產品本身並無擴張環（含外框及軟性透明薄膜），無從與透明石英盤（吸盤）形成密閉空間，因此系爭產品並未具有系爭專利請求項1之1E技術特徵「一真空產生器，連接至該密閉空間並用以對該密閉空間抽氣」。

(6)1F技術特徵：

上訴人固提出原證7之影片，主張系爭產品搭配擴張環使用符合1F技術特徵。惟如前述，系爭產品本身不具有「擴張環」（含外框及軟性透明薄膜），無從與透明石英盤形成密閉空間，即未具有系爭專利請求項1之1F技術特徵「其中，當該透明載體接合於該間隔構件上且該真空產生器對

該密閉空間抽氣時，該軟性透明載體部分平貼於該第一面上以形成一檢測區，該檢測區係用以承載該覆晶式發光二極體」。

(7)綜上，由於系爭產品本身並無擴張環，欠缺系爭專利請求項1之1C「間隔構件」及1D「軟性透明載體」，亦無從與透明石英盤構成1D至1F所示「密閉空間」之技術特徵，故系爭產品並未包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，不符合全要件原則，即未落入系爭專利請求項1之文義範圍，自不構成文義侵權。

(8)此外，系爭專利請求項2至4、7係請求項1之直接或間接附屬項，包含請求項1之全部技術特徵。由於系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，業如前述，則系爭產品自未落入系爭專利請求項2至4、7之文義範圍。

(二)系爭產品搭配擴張環組合使用後，共同構成對系爭專利請求項1至4、7之均等侵權：

1.被上訴人明知或可預見系爭產品得搭配擴張環使用，兩者具有共同關連性：

(1)我國專利侵權判斷係採全要件原則，是被控侵權物須實施專利之全部技術內容，始構成侵害專利權之行為。亦即，專利請求項中每一技術特徵均應完全對應表現於被控侵權物，始能構成專利權之直接侵害。如被控侵權物僅實施專利之部分技術內容，致不符合全要件原則，而未構成專利權之直接侵害時，則應進一步探討是否構成專利權之間接侵害。我國專利法就專利權之間接侵害，並無明文規定，自應回歸民法第185條共同侵權行為加以判斷。復按民法第185條規定，數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人視為共同行為人。依此規定，共同侵權行為可分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助三種，其因共同加害行為而成立共同侵權行為者，除共同行為人均須具備侵權行為之要件外，須共同行為人之行為具有共同關聯

性為其要件（最高法院101年度台上字第720號判決意旨參照）。

(2)擴張環並非系爭產品之附屬構件，已於前述，惟系爭產品已於市場上販售、流通，上訴人曾向惠特公司業務人員詢問系爭產品是否可使用塑膠環或Disco Frame？經該業務人員答以子母環、Disco Frame均能上機使用（原審卷一第479頁之原證23），故系爭產品可搭配擴張環（塑膠環、子母環）或Disco Frame使用。又系爭產品的吸盤上設有圓形凹槽，可供擴張環放置，實際操作時係將擴張環放入吸盤，開啟機器進行抽真空動作，此經本院勘驗屬實（二審卷一第445、458至463頁之勘驗筆錄附件及照片），系爭產品規格書封面上方圖片亦顯示搭配擴張環使用之情形（原審卷一第63頁），堪認被上訴人係明知或可預見他人有將系爭產品搭配擴張環使用之行為存在。因此，關於本件是否構成共同侵權行為之判斷，自應以系爭產品與擴張環組合後之技術內容與系爭專利進行比對。

2.系爭產品與擴張環組合使用後應構成系爭專利請求項1之均等侵權：

(1)1A、1B之技術特徵：系爭產品具有系爭專利請求項1之1A、1B技術特徵，詳如前述第(一)、3.、(2)及(3)點所述，不另贅述。

(2)1C技術特徵：

①依原證6第8頁（原審卷一第82頁），擴張環與系爭產品一併使用時，該擴張環之外框雖可對應於1C技術特徵之「間隔構件」，然該擴張環之外框並非置於高透明石英盤之一面上，而是置於高透明石英盤周圍金屬座體（上訴人將之稱為「吸盤」）之環形凹槽中，並不全然符合1C技術特徵「一間隔構件，設置於該（透明基板）第一面上」。

②上訴人雖主張「透明基板」之解釋為檢測區透明即可，系爭產品之吸盤即對應系爭專利請求項1之「透明基

板」，擴張環之外框置於金屬座體對應於前述1C技術特徵云云。惟如前揭本院對「透明基板」之解釋，係指可透光之板狀元件，且不應將「檢測區」納入解釋；而其既為「透明」或「可透光」之基板（板狀元件），自然僅能對應於系爭產品之高透光石英盤；是以擴張環之外框既係置於金屬座體（吸盤之環形凹槽）而非高透光石英盤上，即與1C之技術特徵不符，上訴人之主張並非可採。

(3)1D技術特徵：

①依原證6第7、8頁（原審卷一第81、82頁）所示，擴張環上具有「軟性透明薄膜」，可拆卸地接合於擴張環之橘色外框上（由內框將軟性透明薄膜夾置於外框上），而當擴張環置於吸盤（高透光石英盤周圍之環形凹槽）上時，軟性透明薄膜、外框及吸盤（非僅高透光石英盤）之上表面間形成一密閉空間，與1D技術特徵「一軟性透明載體，可拆卸地接合於該間隔構件上，其中當該軟性透明載體接合於間隔構件上時，該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板之該第一面之間形成一密閉空間」相較，二者構成密閉空間之構件略有差異，即系爭專利以軟性透明載體、間隔構件及透明基板三者形成密閉空間，系爭產品則以軟性透明薄膜、擴張環外框以及吸盤（含高透光石英盤及其周圍之環形凹槽）三者形成密閉空間。

②被上訴人雖辯稱擴張環與系爭產品之吸盤均為剛性物質，其間或有間隙存在無法達到無氣漏之程度，因此無法構成密閉空間；本院112年8月21日勘驗時，被上訴人更主張當抽真空後，仍得以紙片伸入擴張環與吸盤間，並非密閉空間云云（二審卷一第464至466頁）。惟專利侵權之認定，係以專利請求項而非說明書內容與系爭產品進行比對，如前述本院對「密閉空間」用語之解釋，係指「由軟性透明載體、間隔構件及透明基板所共同界

定之氣密空間」，並未限定其氣密程度如何。再者，本院勘驗系爭產品時，已確認系爭產品之高透光石英盤周圍設有數個小孔，該些小孔係藉由管路連通至真空幫浦（真空產生器）；附有軟性透明載體之擴張環置於高透光石英盤周圍之環形凹槽時，軟性透明載體乃覆蓋於小孔上方，是以除該些小孔連通於真空產生器外，軟性透明載體、擴張環外框與吸盤（含高透光石英盤）三者所界定之空間，可供抽真空後使軟性透明載體即貼附於高透光石英盤上，此有本院之勘驗程序筆錄及照片可稽（二審卷一第445至460頁），即應符合1D之技術特徵，故被上訴人所辯自非可採。

(4)1E技術特徵：依原證6第9、10頁（原審卷一第83、84頁）所示，系爭產品外殼上設有開啟真空功能之按鈕，且吸盤下方設有真空管路連接至吸盤側邊；另依本院勘驗筆錄及照片所示（二審卷一第445至447、455至458頁），系爭產品之機台旁擺置一真空幫浦即對應1E技術特徵之真空產生器，上訴人表示該真空幫浦係連接至吸盤外部周圍的透明管路，及吸盤（高透光石英盤）周圍的數個小孔，均為被上訴人所不爭執。而如前述1D技術特徵所述，高透光石英盤周圍數個小孔係連通於由軟性透明載體、擴張環外框與吸盤所構成之氣密空間，可對應於系爭專利請求項1之1E「一真空產生器，連接至該密閉空間並用以對該密閉空間抽氣」技術特徵。

(5)1F技術特徵：依原證7（原審卷一第93頁光碟片）所示，將擴張環置於系爭產品吸盤上的環形凹槽，開啟真空產生器對密閉空間抽氣時，擴張環之軟性透明載體會平貼於高透光石英盤，且該軟性透明載體上可承載覆晶式發光二極體，供後續進行檢測；另本院勘驗確認當系爭產品進行抽真空後，擴張環上之軟性透明薄膜會平貼於高透光石英盤上，以致於擴張環無法被移動（二審卷一第447、464頁）

，自可對應於系爭專利請求項1之1F「其中，當該透明載體接合於該間隔構件上且該真空產生器對該密閉空間抽氣時，該軟性透明載體部分平貼於該第一面上以形成一檢測區，該檢測區係用以承載該覆晶式發光二極體」技術特徵。

(6)綜上，系爭產品與擴張環組合後雖具有系爭專利請求項1之1A、1B、1E及1F技術特徵，然就1C、1D技術特徵仍有部分差異，亦即擴張環之外框係置於系爭產品之金屬座體上，而非如1C界定間隔構件置於透明基板（第一面）上；以及系爭產品係以其吸盤，與擴張環之軟性透明薄膜、外框形成密閉空間，而非如1D係以透明基板、軟性透明載體、間隔構件形成密閉空間。是以，系爭產品與擴張環之組合未包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，雖未構成文義侵權。

(7)惟就均等論之比對而言，系爭產品與擴張環之組合與系爭專利請求項1之差異僅在於1C、1D技術特徵：即二者關於擴張環之外框（對應系爭專利之間隔構件）設置位置，及形成密閉空間之構件，略有差異。由於系爭產品與擴張環之組合，係藉由將擴張環之外框設於金屬座體之方式，達成外框、吸盤及軟性透明薄膜形成密閉空間之功能、結果，其與系爭專利藉由將間隔構件設於透明基板之方式，達成間隔構件、透明基板及軟性透明載體形成密閉空間之功能、結果，二者間之差異僅為間隔構件設置位置之簡單改變，且改變前後所執行之功能及得到的結果均為實質相同，自應適用均等論，構成均等侵權。

3.系爭產品與擴張環組合使用後應構成系爭專利請求項2至4、7之均等侵權：

(1)系爭專利請求項2至4、7係請求項1之直接或間接附屬項，包含請求項1之全部技術特徵。因系爭產品與擴張環之組合未構成系爭專利請求項1之文義侵權，俱如前述，自未構成對系爭專利請求項2至4、7之文義侵權。

01 (2)系爭專利請求項2係請求項1之附屬項，並界定「進一步包
02 含一光檢測器，該光檢測器係用以接收自該透明基板而來
03 之光線」附屬技術特徵。依原證5第4頁（原審卷一第67
04 頁）所示，系爭產品於吸盤下方設有積分球，用以接收穿
05 過高透光石英盤之光線，即對應前述附屬技術特徵。又系
06 爭產品與擴張環之組合構成系爭專利請求項1之均等侵
07 權，已如前述，故其組合亦構成系爭專利請求項2之均等
08 侵權。

09 (3)系爭專利請求項3係依附於請求項2，並界定「進一步包含
10 一探針組，用以接觸承載於該檢測區上之該覆晶式發光二
11 極體的一P-N電極，以及對該P-N電極供給一檢測電源」附
12 屬技術特徵。依原證5第4頁（原審卷一第67頁）或系爭產
13 品照片（同上卷第87頁）所示，系爭產品於吸盤上方設有
14 探針組，用以接觸承載檢測區上之覆晶式發光二極體之P-
15 N電極，以及對P-N電極供給電源（原證5第4頁顯示針座連
16 接於「電流源」），即對應前述附屬技術特徵。又系爭產
17 品與擴張環之組合構成系爭專利請求項2之均等侵權，已
18 如前述，故其組合亦構成系爭專利請求項3之均等侵權。

19 (4)系爭專利請求項4係依附於請求項3，並界定「當該探針組
20 接觸接觸承載於該檢測區上之該覆晶式發光二極體的該P-
21 N電極並供給該檢測電源時，該覆晶式發光二極體對應該
22 檢測電源而發光穿過該軟性透明載體之該檢測區以及該透
23 明基板」附屬技術特徵。依原證5第4頁或原證6第15頁
24 （原審卷一第89頁），當該探針組接觸接觸承載於檢測區
25 上之覆晶式發光二極體的P-N電極並供給檢測電源時，該
26 覆晶式發光二極體對應檢測電源而發光穿過軟性透明薄膜
27 之檢測區以及高透光石英盤，即對應前述附屬技術特徵。
28 又系爭產品與擴張環之組合構成系爭專利請求項3之均等
29 侵權，已如前述，故其組合亦構成系爭專利請求項4之均
30 等侵權。

01 (5)系爭專利請求項7係依附於請求項1，並界定「該真空產生
02 器進一步包含一管路，並且該管路係穿過該透明基板而與
03 該密閉空間連接，該真空產生器係透過該管路對該密閉空
04 間抽氣」附屬技術特徵。依原證6第17頁（原審卷一第91
05 頁）所示，系爭產品於吸盤下方設有管路，穿過該吸盤而
06 與密閉空間連接，該真空產生器係透過該管路對該密閉空
07 間抽氣，即對應前述附屬技術特徵。又系爭產品與擴張環
08 組合構成系爭專利請求項1之均等侵權，已如前述，故其
09 組合亦構成系爭專利請求項7之均等侵權。

10 (三)系爭專利之先前技術及乙證2之組合，足以證明系爭專利請
11 求項1至4、7不具進步性：

12 1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
13 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟
14 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其
15 他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤
16 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於
17 他造主張權利，修正前智慧財產案件審理法第16條定有明
18 文。本件被上訴人既以附表所列舉發證據組合，抗辯系爭專
19 利請求項1至4、7有應撤銷之原因，法院自應審酌上開系爭
20 專利請求項是否有應撤銷事由而不得主張權利之情事存在。
21 又系爭專利申請日為100年（西元2011年）7月14日，審定日
22 為103年1月27日，是否有應撤銷專利權之情事，自應以審定
23 時所適用之100年12月21日修正、102年1月1日施行之專利法
24 （下稱核准時專利法）為斷。次按「發明雖無前項各款所列
25 情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先
26 前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。核准時專
27 利法第22條第2項定有明文。

28 2.系爭專利之先前技術及乙證2之組合，足以證明系爭專利請
29 求項1不具進步性：

30 (1)系爭專利請求項1與其說明書所載之先前技術比對：

01 ①系爭專利圖1A及說明書第5頁末段載明「…圖一A係…覆
02 晶式發光二極體量測設備之載具1的示意圖」、「載具1
03 包含基板10以及承載體12，兩者均為高透光之材質」，
04 前述覆晶式發光二極體量測設備及其高透光材質之基板
05 (10)，即對應於系爭專利請求項1之1A、1B「一種發光
06 二極體量測裝置，用於量測一覆晶式發光二極體，該發
07 光二極體量測裝置包含：一透明基板，具有一第一面」
08 技術特徵。又系爭專利圖1A揭示於承載體(12)上設有透
09 明載體(16)，系爭專利說明書第6頁第1段亦載明「…當
10 抽氣裝置14對該空間抽氣時，空間中產生的負壓透過氣
11 孔120將承載於承載體12上之透明載體16固定住…」，
12 前述透明載體(16)及抽氣裝置(14)即分別對應於系爭專
13 利請求項1之1D「軟性透明載體」、1E「真空產生器」
14 技術特徵。

15 ②惟依系爭專利說明書所載之先前技術，並未揭露有相當
16 於系爭專利請求項1之1C「間隔構件」，亦無系爭專利
17 請求項1之1D「該軟性透明載體、該間隔構件及該透明
18 基板之該第一面之間形成一密閉空間」，及1F「當該透
19 明載體接合於該間隔構件上且該真空產生器對該密閉空
20 間抽氣時，該軟性透明載體部分平貼於該第一面上以形
21 成一檢測區」之技術特徵。

22 (2)系爭專利說明書所載之先前技術與系爭專利請求項1之差
23 異技術特徵，已為乙證2(中譯本參乙證2-1)所揭露：

24 (1)比對乙證2與系爭專利請求項1之技術內容：

25 依乙證2圖4(a)、4(b)揭露一種鐳射加工裝置，乙證2說
26 明書第[0018]段記載「…載置臺的鐳射照設部由玻璃形
27 成」、第[0025]段記載「18是粘接並固定具有吸收鐳射
28 的部位作為被加工物的半導體晶圓19的固定片材部
29 件，單面由粘接層形成，由透射鐳射的材質構成。20是
30 用於以拉伸固定片材部件18的周圍的狀態進行保持的固
31 定環…」、第[0043]段記載「…在載置臺34上載置固定

片材部件18(圖4(a))…使真空泵23動作…施加所希望的負壓，使載置臺34真空吸附固定片材部件18(圖4(b))…變形為載置臺34的上表面的倒梯形的凹部34a的形狀而被吸附」。乙證2揭露載置臺(34)周邊部分較高而中間部分較低，使固定片材部件(18)與載置臺(34)中間部分相距一距離，乙證2之載置臺(34)即對應揭露系爭專利請求項1之透明基板及1C「間隔構件」；乙證2揭露之固定片材部件(18)及真空泵(24)，則分別對應揭露系爭專利請求項1之軟性透明載體及真空產生器。

(2)又乙證2圖4(a)、4(b)（及說明書第[0043]段）揭露真空泵(23)對於固定片材部件(18)與載置臺(34)間之密閉空間進行抽氣，固定片材部件(18)與載置臺(34)間（即凹部(34a)）形成一「密閉空間」，對應揭露系爭專利請求項1之1D「該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板之該第一面之間形成一密閉空間」技術特徵；且乙證2之固定片材部件(18)受負壓吸附而部分平貼於載置臺(34)上，即對應揭露系爭專利請求項1之1F「…該真空產生器對該密閉空間抽氣時，該軟性透明載體部分平貼於該第一面上以形成一檢測區…」技術特徵。

(3)基上，依系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2，已共同揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵。又系爭專利說明書所載之先前技術係關於發光二極體(半導體晶片)檢測裝置，乙證2之技術內容係半導體晶片之雷射加工裝置，二者均為半導體後段製程所使用之設備，屬相同或相關之技術領域。而系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2，均使用透明基板以及軟性透明載體為設備構件，並以軟性透明載體來承載半導體晶片，於功能、作用上具有共通性。再者，乙證2說明書第[0007]至[0009]段(第[0043]至[0044]段等)已教示利用在載置臺設有吸附用孔，透過真空吸附方式將載置有半導體晶片之固定片材固定於載置臺上，可避免加工中之半導體晶片上下左右移動之問題。是

以，依據系爭專利說明書所載之先前技術與乙證2間技術領域之關連性、功能或作用上之共通性，以及乙證2之教示或建議等因素，所屬技術領域中具有通常知識者應有合理動機組合系爭專利說明書所載之先前技術與乙證2；尤當通常知識者基於系爭專利說明書之先前技術，面對到如何解決透明載體受負壓吸引而產生變形之問題時，當能依據乙證2圖4(a)、4(b)及相關內容所教示，據以修飾系爭專利說明書所載之先前技術，使透明載體(固定片材部件)被真空吸附平貼於載置台上，從而輕易完成系爭專利請求項1所界定之發明，準此，系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

- (4)上訴人固主張系爭專利之先前技術與乙證2不僅技術領域不同、所欲解決問題不同，亦不存在關聯性，通常知識者顯無動機參考乙證2之技術並予以應用或組合以完成系爭專利之技術特徵等等（二審卷二第113至121頁）。惟查，判斷所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數先前技術之內容時，係綜合考量先前技術間有關「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等因素，意即個案上並非前述所有因素均需具備始能認定具有組合動機。次就技術領域之關連性而言，係以複數先前技術之技術內容的技術領域是否「相同或相關」予以判斷，而判斷時得就應用該技術之物、原理、機制或作用等予以考量。系爭專利之先前技術既係關於發光二極體(半導體晶片)檢測裝置，並利用負壓將承載發光二極體之透明載體予以固定(參系爭專利說明書第5頁末段至第6頁第1段)；乙證2之技術內容則係半導體晶片之雷射加工裝置，其圖4(a)、4(b)揭示係利用負壓將承載半導體晶圓(19)之固定片材部件(18)予以固定，可見系爭專利之先前技術與乙證2均以半導體晶片(晶圓)為施作對象，據以進行晶粒切割、檢測等半導體後

01 段製程所使用之設備(可參二審卷二第193頁簡報或第225
02 頁簡報之流程圖)，二者縱非相同，亦應屬相關技術領
03 域。又既然二者均使用透明基板(載置臺)、透明載體(固
04 定片材部件)為設備構件，並透過負壓吸引原理來固定承
05 載半導體晶片(晶圓)之透明載體(固定片材部件)，就承載
06 晶片或固定透明載體等功能、作用上具有共通性。乙證2
07 說明書第【0007】段揭示其欲解決問題之一係加工中之半
08 導體晶圓位置上下左右移動所導致的加工精度低下，而其
09 圖4(a)、4(b)揭示之實施例，係透過真空吸附方式將載置
10 有半導體晶圓之固定片材固定於載置臺上，甚而不會殘留
11 氣泡於載置臺與固定片材部件之間(參乙證2第[0044]段，
12 同上卷第119頁)，對於解決系爭專利先前技術所面臨負壓
13 吸附時透明載體變形以致發光二極體晶片位置偏轉之問
14 題，具備相關的教示或建議。客觀上綜合考量前述各因素
15 後，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機組合系
16 爭專利之先前技術與乙證2之技術內容。故上訴人之主張
17 並不可採。

- 18 (5)上訴人雖主張縱將乙證2圖4與系爭專利之先前技術組合，
19 然乙證2之載置台係完整結構，不能等同於系爭專利之透
20 明基板與間隔構件兩個組件，且乙證2之載置台特殊構造
21 係使固定片材部件可完整的平貼到載置台上部，乙證2之
22 載置台結構較系爭專利之透明基板與間隔構件更複雜、加
23 工困難度高云云(二審卷二第120至121頁、第199頁)。然
24 而，專利進步性之判斷，係以申請專利範圍所載之發明為
25 準，而系爭專利請求項1並未限定「透明基板」、「間隔
26 構件」之尺寸、形狀為何，亦未排除一體成型之可能性，
27 解釋上即包含各種可能的構造，當不能以之作為與乙證2
28 倒梯形載置台具有差異之論據，甚且據此推論因形狀、構
29 造上有差異而產生乙證2所無之功效；再者，系爭專利請
30 求項1係界定真空產生器對密閉空間抽氣時「軟性透明載
31 體『部分』平貼於該第一面上以形成一檢測區」，而如上

訴人所述，乙證2係揭露固定片材部件「完整」平貼於載置台(含中央平坦部分與兩側斜面部分)，此即表示固定片材部件至少有部分係平貼於載置台中央平坦部分(參乙證2圖4(b))，而對應於前述系爭專利請求項1技術特徵，此部分並無上訴人所謂之差異存在，故其所稱即非可採。

(6)上訴人另主張系爭專利說明書所載之先前技術，係發明人內部、未公開之研究成果，並非適格之先前技術，亦非組合先前技術之動機等等(原審卷二第477至481頁)。惟所謂先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，說明書應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，且據以進行檢索、審查，此於系爭專利核准時專利法第22條第1項、專利法施行細則第17條第1項第3款及專利審查基準第二篇第一章第1.2.3節等均有明文規定。故發明說明書中所載之先前技術，既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可做為判斷系爭專利是否具專利要件之證據。況上訴人雖主張系爭專利說明書所載之先前技術係屬內部、未公開之研究成果，然未提出任何證據以實其說，自難憑採。

3.系爭專利之先前技術及乙證2之組合，足以證明系爭專利請求項2至4、7不具進步性：

(1)系爭專利請求項2係請求項1之附屬項，並界定「進一步包含一光檢測器，該光檢測器係用以接收自該透明基板而來之光線」附屬技術特徵。查系爭專利說明書所載之先前技術已記載「覆晶式發光二極體2所發出之光可穿過透明載體16、承載體12與基板10而被光檢測器所感測」(系爭專利說明書第6頁第5至6行)，即對應於前述附屬技術特徵；又系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合足以證

明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，故系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合亦足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

(2)系爭專利請求項3係依附於請求項2，並界定「進一步包含一探針組，用以接觸承載於該檢測區上之該覆晶式發光二極體的一P-N電極，以及對該P-N電極供給一檢測電源」附屬技術特徵。又系爭專利請求項4係依附於請求項3，並界定「當該探針組接觸接觸承載於該檢測區上之該覆晶式發光二極體的該P-N電極並供給該檢測電源時，該覆晶式發光二極體對應該檢測電源而發光穿過該軟性透明載體之該檢測區以及該透明基板」附屬技術特徵。查系爭專利說明書所載之先前技術已記載「…以探針接觸電極使得發光二極體發光，再透過光檢測器(例如積分球或太陽能電池)量測光源，同時藉探針量測發光二極體之電性…」(系爭專利說明書第5頁第2段)，而發光二極體具有P-N電極乃一般通常知識；又系爭專利說明書第6頁第5至6行另載「覆晶式發光二極體2所發出之光可穿過透明載體16、承載體12與基板10而被光檢測器所感測」，前述內容即對應於系爭專利請求項3、4之附屬技術特徵。又系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述，故系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合亦足以證明系爭專利請求項3、4均不具進步性。

(3)系爭專利請求項7係依附於請求項1，並界定「該真空產生器進一步包含一管路，並且該管路係穿過該透明基板而與該密閉空間連接，該真空產生器係透過該管路對該密閉空間抽氣」附屬技術特徵。查系爭專利說明書所載之先前技術記載「…承載體12上具有複數個氣孔120，當抽氣裝置14對該空間抽氣…」(系爭專利說明書第6頁第1段)，另依乙證2圖4(a)、4(b)揭露連接於真空泵(23)之管路係穿過主體(16)而與密閉空間連接，真空泵(23)係透過該管路

對該密閉空間抽氣，即對應於前述附屬技術特徵。又系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，故系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合亦足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

4.又系爭專利說明書所載之先前技術及乙證2之組合既足以證明系爭專利請求項1至4、7不具進步性，詳如前述。則系爭專利說明書所載之先前技術、乙證1及乙證2之組合；或先前技術、乙證1、乙證2及乙證3之組合，均足以證明系爭專利請求項1至4、7不具進步性。至於被上訴人所提其餘證據組合是否足以證明系爭專利請求項1至4、7不具進步性，以及可否主張專利法第59條第1項第3款之系爭專利效力所不及之事由，即均無審究之必要，附此敘明。

5.基上，由於系爭專利請求項1至4、7有應撤銷之事由，則縱使被上訴人之系爭產品與擴張環組合使用後共同構成系爭專利請求項1至4、7之均等侵權，上訴人仍不得向被上訴人主張權利，是其主張被上訴人應負排除侵害及侵權行為連帶損害賠償之責任，即屬無據，且被上訴人製造、販賣系爭產品所得利益亦難認無法律上原因，更核無不法無因管理之要件。

七、綜上所述，上訴人依專利法第96條第1項規定，請求被上訴人排除侵害，及依同法第96條第2頁、第97條第1項第2款、第2項、民法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段、第185條及公司法第23條等規定，請求被上訴人連帶給付1,000萬元之本息，均無理由。從而，原判決以系爭產品未落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍，而駁回上訴人之訴及假執行聲請，所持理由雖與本院不同，惟核其判決結果並無二致，應予維持。上訴人就原判決提起上訴，請求予以廢棄改判如上訴聲明所示，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列。

九、結論：本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 11 月 28 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 陳端宜

法 官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 112 年 12 月 8 日

書記官 蔣淑君

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

附表：

編 號	內 容	公開/公告日 (西元)
乙證1	日本昭第62-174608A號「圖案檢測裝置」專利案	1987年7月31日
乙證2	日本特開第2000-164535A號「鐳射	2000年6月16日

01

	加工裝置」專利案	
乙證3	日本特開第2007-19237A號「雙面發光元件探測器」專利案	2007年1月25日
乙證4	美國公告之第US6384612B2號「用於檢測發光裝置之光輸出的方法及裝置」專利	2002年5月7日
乙證6	大陸公告之第CN201161468Y號「基板貼合裝置」專利。	2008年12月10日
上開證據公開或公告日皆早於系爭專利申請日2011年7月14日，均得作為系爭專利之先前技術。		

02

系爭專利 請求項	被上訴人所提舉發證據組合(乙證) (原審卷二第447至449、460頁)	
1-4、7	先前技術(系爭專利)	
	先前技術+1	
	先前技術+2	
	先前技術+1+2	
	先前技術+1+2+3	
	先前技術+6	
1、2	1	
	1+2	
	1+2+3	
3、4、7	先前技術+3	
	先前技術+1+3	
3、4	先前技術+1+2+4	
4	先前技術+1+2+3+4	